

会社連絡先:

RF Micro Devices Inc.
Irma Swain, Communications Manager
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
電話: +1 (336) 931-6653
iswain@rfmd.com

RFMD 社、第一世代窒化ガリウム(GaN)プロセスの技術評価を完了

GaN 技術は同社マルチマーケット・プロダクツ・グループの製品を広範囲にサポート

ニューヨーク州ニューヨーク、2007 年 11 月 21 日: 高性能 RF システム/ソリューションの設計、製造で世界をリードする RFMD 社(ナスダック GS: RFMD)は、本日開催された同社のアナリストデーで、第一世代 48V 窒化ガリウム(GaN)プロセス技術の技術評価が完了したことを明らかにした。

RFMD 社は化合物半導体で世界最大のメーカー。化合物半導体の設計/量産を可能にする既存製造設備と実績のある専門技術を活用し、新しい GaN プロセス技術でも優れた熱性能と RF 性能を引き出した。RFMD 社の 48V GaN 技術による量産試作品は既に複数のエンドマーケット向けに出荷されている。

RFMD 社の 48V GaN プロセス技術は、ユーザーから要求される高出力化、高効率化、広帯域化に対応する上で理想的な技術。同社は高い直線性が要求される CATV 用ラインアンプ、軍用レーダー、無線インフラ用の広帯域パワーアンプ、革新的な高輝度発光デバイス用の電源モジュールなど、様々な高成長分野をターゲットにしている。

「当社には、新しい GaN 技術の恩恵を受けられる、開発中や製品化済の様々な製品があります。立ち上げたばかりのマルチマーケット・プロダクツ・グループ(MPG)にとって、この新プロセス技術は競争に勝つための即戦力となります。MPG が成長を続けながら複数のエンドマーケットに GaN 技術を展開していくことにより、売上げや粗利の拡大に対する会社の期待に応えることができます。」と RFMD 社マルチマーケット・プロダクツ・グループの社長ボブ・ヴァン・バスカークは語る。

バスカークはさらに続けて、「RFMD 社の GaN プロセス技術は従来の技術に比べ、高効率化や動作帯域の広帯域化、信頼性の向上が図れます。これら性能上の特性は、高成長が期待される様々な用途で有利な設計を可能にしています。」という。

技術概要

RFMD 社の高効率、高出力 GaN プロセス技術により、たとえば 2.1GHz、48V 動作で Psat が平均 5.6W/mm、平均ピーク PAE が 60%以上、小信号利得 24dB といったクラス最高の RF 性能が得られ、また GaN 技術に固有の優れた電気的特性や卓越した高信頼性により従来の技術よりも広帯域化、高出力、高効率化が可能になる。複数ロットのウェーハ、3 点の設定温度での試験結果に基づく動作ジャンクション温度 180°Cでの平均

故障時間(MTTF)の計算値は 1×10^6 時間以上。

RFMD 社について:RF マイクロデバイス社(NASDAQ GS RFMD)は、無線通信／ブロードバンド通信駆動用各種アプリケーション向けの高性能無線システム／ソリューションを設計、製造する業界リーダー。RFMD 社の携帯電話用フロントエンド、携帯電話用トランシーバ、システムオンチップ(SOC)ソリューションは携帯端末、携帯電話基地局、無線 LAN(WLAN)、CATV ネットワーク、航空宇宙、防衛、GPS 等の市場で活用され、その最先端の機能をサポートして通信能力を強化し、世界全体のモビリティを向上させている。幅広い分野の最新半導体技術と RF システムの専門技術で知られる RFMD 社は、移動通信機器や RF システムを手がける世界中の一流メーカーから最も信頼されている。

ノースカロライナ州グリーンズボロに本社を置く RFMD 社は ISO 9001 および ISO 14001 の認証取得済みのメーカーで、世界各地にエンジニアリング、設計、販売、サービスの拠点を持つ。RFMD 社は RFMD 銘柄で米ナスダックグローバルセレクト市場に上場しています。なお詳しい情報は RFMD 社のホームページ、www.rfmd.com に紹介されている。

「将来的な予測」の記述について

このプレス・リリースには、1995 年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act)がその免責条項として定める「将来的な予測」が含まれています。この「将来的な予測」には当社の計画、目的、説明、主張などについて、またはそれ以外についての記述が含まれていますが、これらの記述は歴史的な事実ではなく、通常は「可能」、「必要」、「予測」、「期待」、「予定」、「計画」、「推測」、「確信」、「推定」、「予想」、「可能性」、「継続」などの用語や類似の用語とともに使用されています。またこれらとは別の表現で「将来的な予測」が記述される場合もあります。この文書に含まれている「将来的な予測」の記述は現時点における経営陣の判断や期待を表していますが、実際の成果や出来事、業績などはこれら記述で表現されたり暗示されたりした内容とは実質的に異なる場合もあります。当社は米国連邦証券取引法により要求される場合を除き、これら「将来的な予測」の記述内容を改訂したり、あるいはその記述の改訂を公表したりする意図を持っていません。RF マイクロデバイス社の事業には多くのリスクや不確実性が内在しており、その内容には四半期毎の経営成果の変動、無線関連市場の発展や成長率、ウエハ製造施設、分子線エビタキシー施設、組み立て施設、試験、テープ、リール施設など各種製造施設の稼働に関するリスク、熟練技術者や開発リーダーを採用・確保する当社の能力、生産歩留りの変動、革新的技術によりコストを削減し正味利益率を改善する能力、新製品を市場に投入する能力、顧客の在庫センターを通して行う委託販売への依存性、製品需要に即応したタイムリーな生産能力の調整を行う能力、限られた顧客への依存性、サードパーティへの依存性などが含まれています。上記以外にも含むこれらリスクや不確実性については米国証券取引委員会の様式 10-K に従った RF マイクロデバイス社の最新アニュアルレポートの中で説明されていますが、このような不確実性のため、これら記述の表現や暗示による内容と実際の成果や出来事、業績とは実質的に異なる場合があります。

RF MICRO DEVICES® および RFMD®は RFMD, LLC の商標である。その他の商品名、商標、登録商標はそれぞれの所有者の財産である。

###